

а 2015 0067

Изобретение относится к способам получения полупроводниковых материалов и может быть использовано в полупроводниковой технологии. Способ получения монокристаллов ZnO из газовой фазы включает их выращивание в закрытом объеме с использованием химических транспортных агентов. В качестве химических транспортных агентов используют HCl с начальным давлением при температуре роста 1..5 атм. и водород, который поддерживают в процессе роста под постоянным давлением равном 50...200% от величины начального давления HCl. Для роста монокристаллов используют затравку ZnO с кристаллографическим направлением [0001]Zn или [000 $\bar{1}$]O. Выращивание осуществляют при температуре 980...1100°C.

П. формулы: 1

Фиг.: 3